

产品目录

1. 特性.....	2
2. 典型应用领域.....	2
3. 产品说明.....	2
4. 器件信息.....	3
5. 管脚定义与功能.....	3
6. 典型应用图.....	3
7. 极限工作参数.....	4
8. 电器特性.....	4
9. 测试曲线图.....	5
10. 应用说明	6/7
11. LAOUT注意事项	8
12. 封装尺寸图	9



SL8313 无感式升压、F类、音频功率放大器

◆ 产品说明

SL8313 是一款内置自适应升压 F 类音频功率放大芯片，具有 AGC 防破音功能、AB/D 类模式切换、自适应、超低底噪、超低 EMI。自适应升压在输出幅度较小时升压电路不工作，功放直接由电源供电，当输出较大时内部自动启动升压电路，功放供电电压为升压电压，达到更大的输出功率。SL8313 有四种 AGC 模式可选择，能满足各种不同的需求，并且保护扬声器避免过载而损坏。芯片具有 AB/D 类切换功能，AB 类时可减少功放对 FM 干扰。全差分结构有效的提高功放对 RF 噪声抑制。Charge Pump 升压方式，无需外部电感、肖特基二极管、达到尽可能减少外围元件，节省成本的目的。

- ◆ 一线脉冲控制
- ◆ 升压电压 6.5V
- ◆ 四种自动增益控制 (AGC)
- ◆ 超低底噪、超低失真
- ◆ 开启、关闭 POP-click 抑制功能
- ◆ 10% THD+N, VBAT=4.2V, 4Ω +15UH 负载下 提供高达 5W 的输出功率
- ◆ 1% THD+N, VBAT =4.2V, 4Ω +15UH 负载下提供高达 4.2W 的输出功率
- ◆ 短路保护 过温保护
- ◆ 关断电流 < 1ua

■ 应用

- ◆ 蓝牙音箱
- ◆ 拉杆音箱
- ◆ 便携式音箱
- ◆ 扩音器
- ◆ 电视机
- ◆ 导航仪

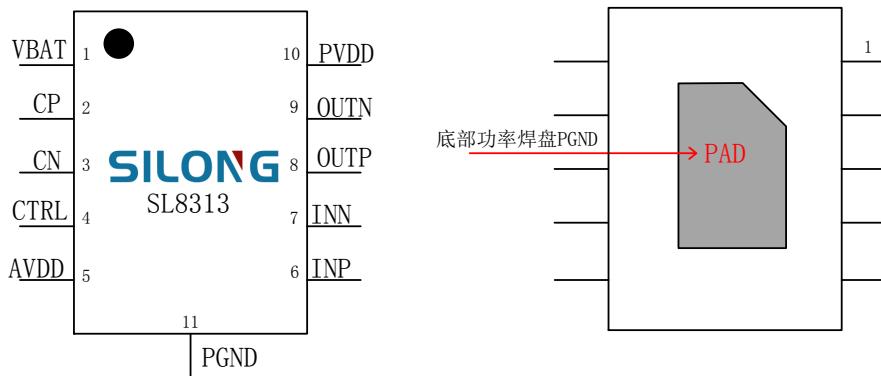
■ 特性

- ◆ 优异的爆破声抑制电路

■ 封装信息

芯片型号	封装类型	封装尺寸
SL8313	ESOP-10	

管脚定义与信息：

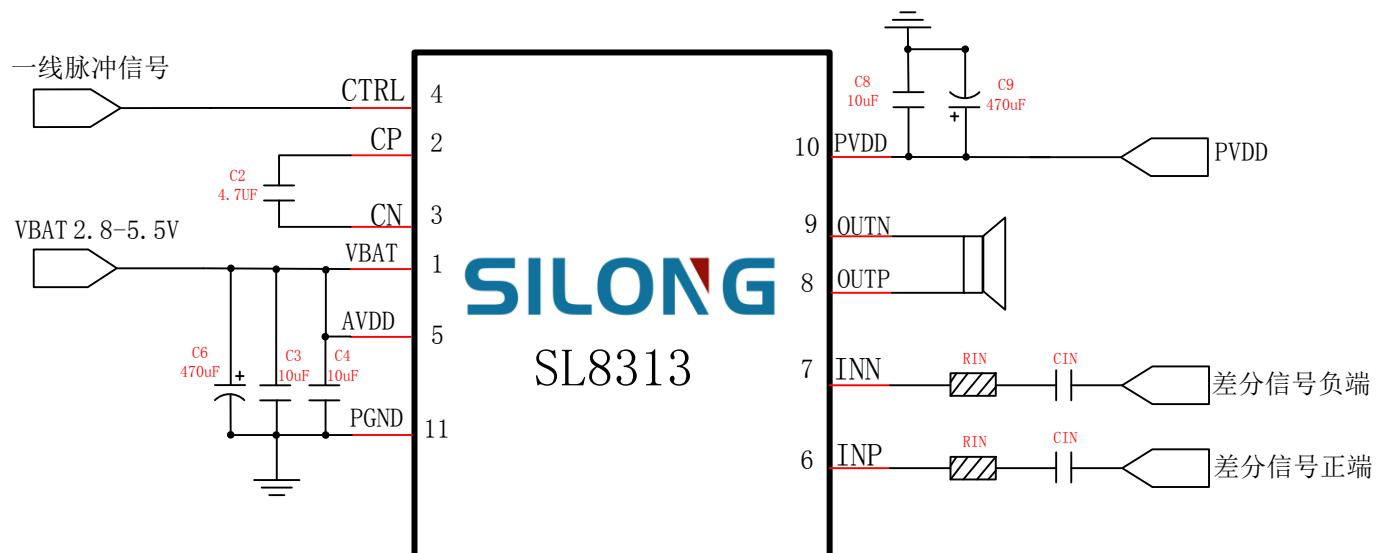


TOP VIEW

BOTTOM VIEW

管脚编号	管脚名称	IO	管脚功能
1	VBAT	I	功率电源正端
2	CP		Flying正端
3	CN	IO	Flying负端
4	CTRL		关断、防破音、AB/D类控制脚
5	AVDD	I	模拟电源正极
6	INP	I	音频信号输入正端口
7	INN	O	音频信号输入负端口
8	OUTP	IO	音频信号输出正端口
9	OUTN	IO	音频信号输出负端口
10	PVDD	O	升压电源管脚, 接电容。
11	PGND	O	电源负极

典型应用图：



极限工作参数:

- 输入电压范围..... 2.8V-5.5V
- CTRL管脚电压..... 0V-5V
- 最大结温..... 150°C
- ESD 电压..... 2000V
- 推荐工作温度范围..... -40°C ~ +85°C
- 储存温度范围..... -65°C ~ +150°C
- 焊接温度 (10S内) +230°C

备注： 超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。

电气特性:

测试条件 $A_v=22dB$, $T_A=25^\circ C$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{BAT}=3.7V, 4\Omega$

描述	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
关断电流	I_{SHDN}	$VDD=3.7V$		-	1	2	μA
静态电流	I_{DD}	$VDD = 3.7V$, D类		-	6	-	mA
		$VDD = 3.7V$, AB类			6		
静态底噪	V_N	$VDD=3.7V$, $A_v=22dB$, A_{Wting}			90		μV_{rms}
输出失调电压	V_{os}	$VIN=0V$			10		mV
D类频率	F_{SW}	$V_{BAT}=4.2V$			500		kHz
启动时间	T_{start}	$V_{BAT}=4.2V$ D类模式			180		Ms
启动时间	T_{start}	$V_{BAT}=4.2V$ AB类模式			86		Ms
增益	A_v	D类模式, $R_{IN}=20k$			≈ 21.5		DB
电源关闭电压	V_{ddsd}	$SD=0$			<2		V
电源开启电压	V_{ddopen}	$SD=0$			≥ 2.8	5	V
过温保护	0_{TP}					180	$^\circ C$
静态导通电阻	R_{dson}	$IDS=0.5A$	P_MOSFET		150		$m\Omega$
		$VGS=4.2V$	N_MOSFET		120		
内置输入电阻	R_s				20		$K\Omega$
内置反馈电阻	R_f				480		$K\Omega$
效率	H_C	$V_{BAT}=4.2V$, $P_{VDD}=6.5V$, $P_0=0.5W$			80		%
高电平电压	H_{Vsel}	3-5V			>3		V
低电平电压	V_{sdopen}	3-5V			<0.5		V
关断电压	OFF_{CTRL}	3-5V			<0.5		V
AB类模式	AB_{CTRL}	3-5V		0.9	11	1.3	
D类模式	D_{CTRL}	3-5V		2.5	3.8	8	
AGC2模式	$AGC2_{CTRL}$	3-5V		1.6	1.8	2	
信噪比	SRN	A 加权, $A_v=22dB$, 1W			-87		DB

● Class_D功率

$A_v=22\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $VDD=4.2\text{V}$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试电压	测试条件	典型值	单位
输出功率	P0	$VDD=4.2$	$f=1\text{kHz}$, $RL=4\Omega$, $\text{THD+N}=1\%$,	4.2	W
		$VDD=4.2$	$f=1\text{kHz}$, $RL=4\Omega$, $\text{THD+N}=10\%$,	5	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $P_{VDD}=6.5\text{V}$, $P_o=1\text{W}$, $R_L=4\Omega$		0.035	%

■ 性能特性曲线

● 特性曲线测试条件 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

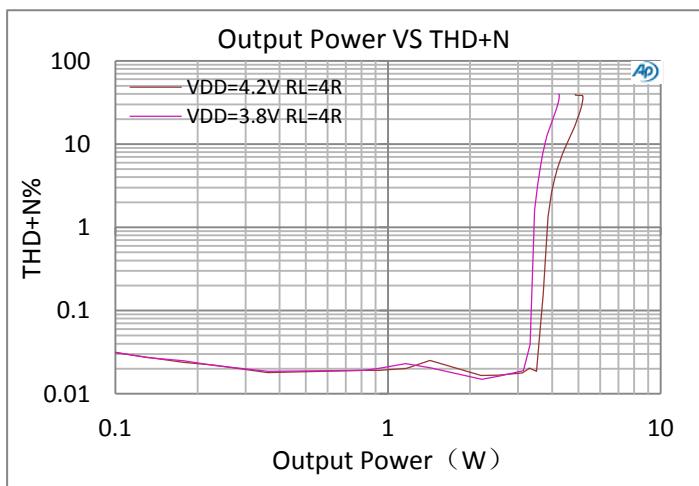


图1: Output Power VS THD+N

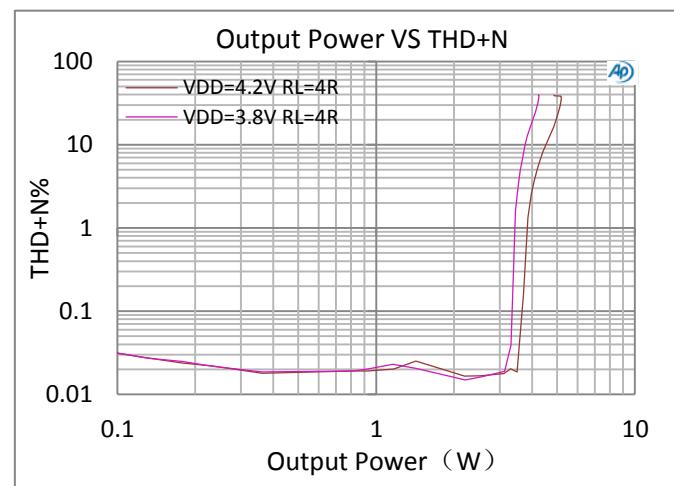


图2: Output Power VS THD+N

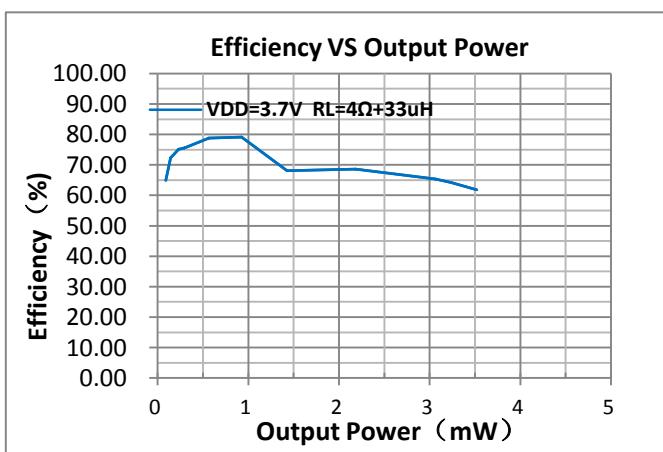


图3: Efficiency VS Output Power

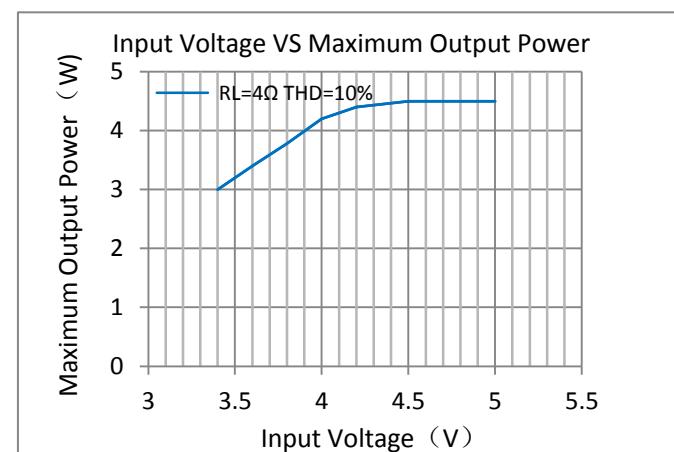


图4: Input Voltage VS Maximum Output Power

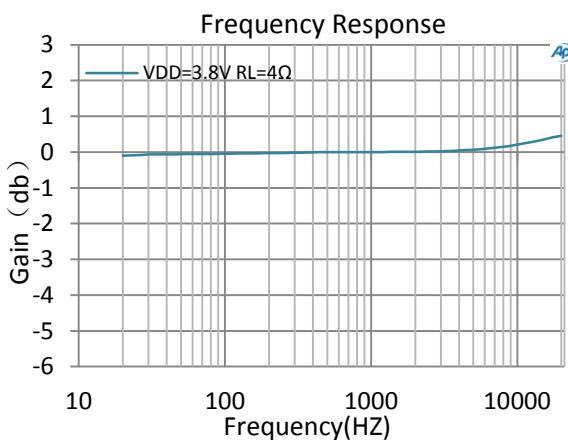


图5: Frequency Response

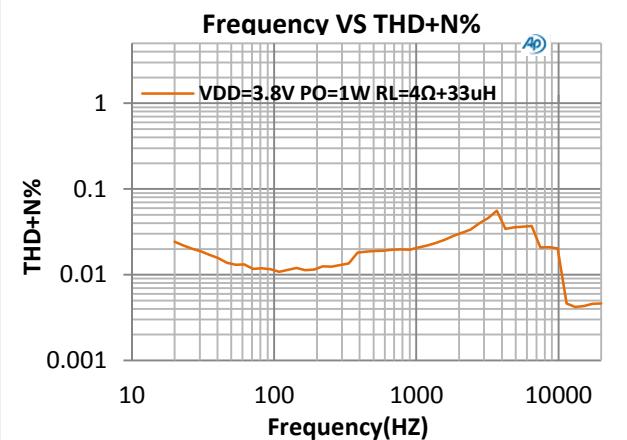


图6: Frequency VS THD+N%

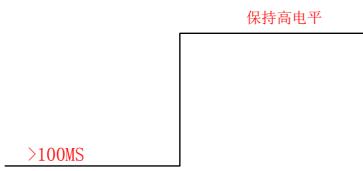
■ 应用说明

SL8313有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。

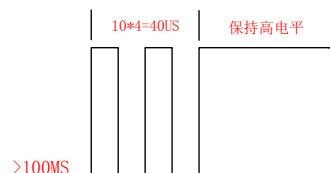
CTRL管脚软件控制（一线脉冲）：CTRL管脚输入不同脉冲信号切换功放:D类防破音1（AGC1: THD $\leq 5\%$ ）、D类防破音2（AGC2: THD $\leq 1\%$ ）、D类防破音3（AGC3: THD $\leq 1\%$ ）、D类防破音4（AGC4: THD $\leq 1\%$ ）、AB类和D类模式。

CTRL管脚软件控制说明（一线脉冲）：CTRL管脚输入不同脉冲信号切换功放AB类、D类各种模式。

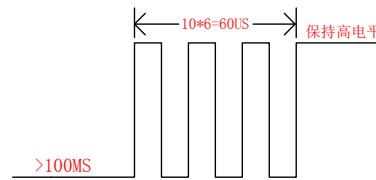
1、芯片切换到D类普通模式波形：



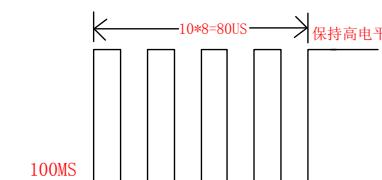
2、芯片切换到D类防破音模式1（THD $\leq 5\%$ ）波形



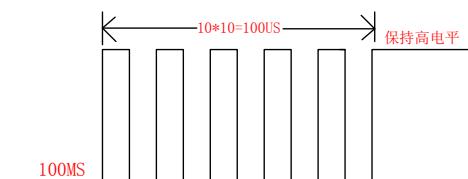
3、芯片切换到D类防破音模式2（THD $\leq 1\%$ ）波形：



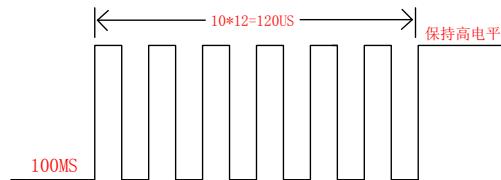
4、芯片切换到D类防破音模式3（THD $\leq 2\%$ ）波形：



5、芯片切换到D类防破音模式4（THD $\leq 2\%$ ）波形：



6、芯片切换到AB类模式波形：



● 硬件控制状态

硬件控制（高低电平控制）：

CTRL管脚电压<0.5V，功放芯片关断。

CTRL管脚电压0.9–1.3V，功放芯片工作在AB类模式升压关闭。

CTRL管脚电压1.6–2V，功放芯片工作在防破音类模式。

CTRL管脚电压2.2–3.3V，功放芯片工作在D类升压模式(无防破音)。

CTRL管脚	芯片状态
<0.5V	关闭状态
0.9–1.3V	AB类模式
1.6–2V	防破音2
2.2–3.3V	D类升压模式状态

● 功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，AB类模式输出模拟信号，其增益均可通过RIN调节。

$$AV = \frac{480k}{20k + R_{IN}}$$

AV为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、20Log倍数= DB。

RIN电阻的单位为KΩ、480KΩ为内部反馈电阻(RF)，20KΩ为内置串联电阻(RS)，RIN由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如RIN=20K时，≈12倍、AV≈22DB

● 输入电容

输入电容(CIN)和输入电阻(RIN)组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_C = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 20K) \times C_{IN}}$$

Cin电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO

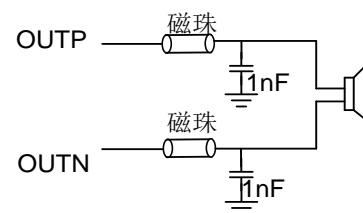
● 电荷泵Flying电容Cf

Flying电容用于在电源和电荷泵之间传递能量，Flying电容容值及电容的ESR直接影响电荷泵的负载能力。Flying电容越大，负载调整能力越强，功放的输出功率越大。推荐使用4.7uF，耐压16V以上低ESR的X7R、X5R陶瓷电容。电荷泵升压输出电容(PVDD) 电荷泵升压输出电容PVDD

的容值和ESR会直接影响电荷泵升压输出电压的稳定性，从而影响功放的整体性能。推荐使用470uF低ESR的电解电容，保持电容的耐压在10V以上。

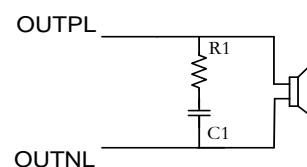
● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



● RC缓冲电路

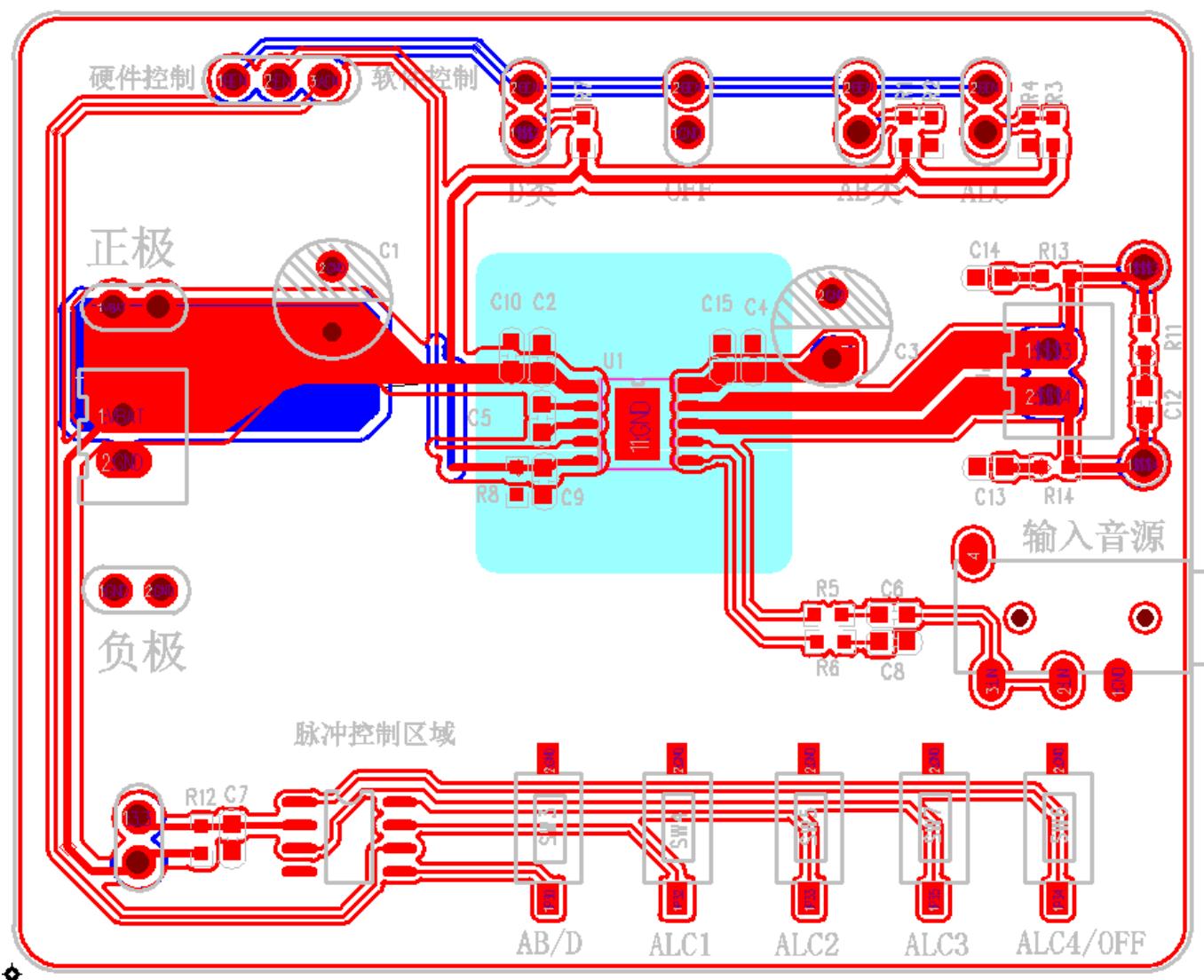
如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用：3Ω–8Ω，电容推荐：500PF–10NF。



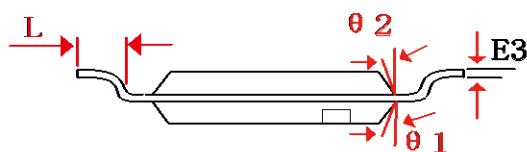
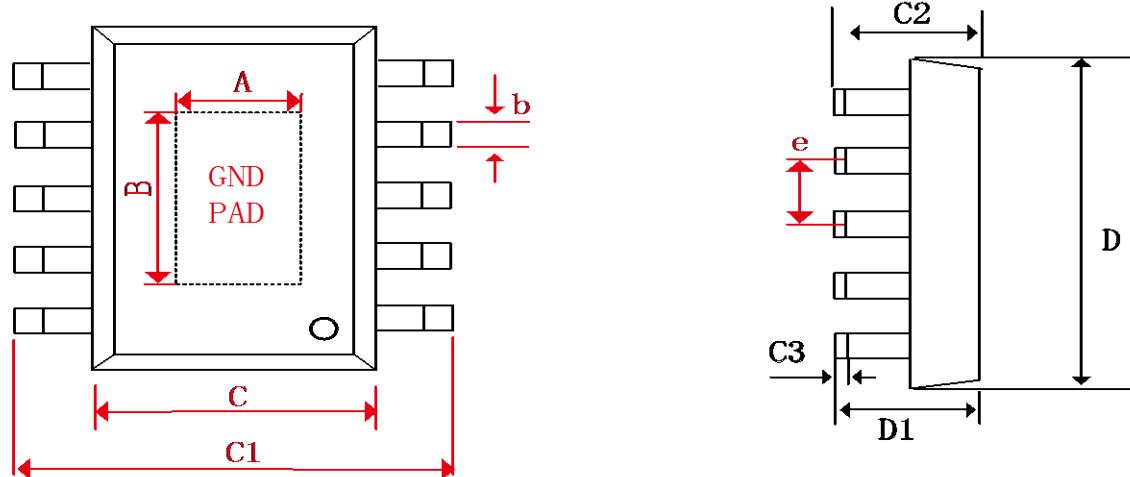
■ PCB设计注意事项

- PVDD 端按负载选用 470UF 或 1000uf 插件电容和 10UF 的陶瓷电容并联，电容尽量靠近 PVDD 管脚。VBAT 端同样选用 470UFV 插件电容和 10UF 的陶瓷电容并联。
- 供电脚 (VBAT、PVDD) 走线尽量粗，最好使用敷铜来连接网络，如走线或敷铜中必须打过孔应使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接将电源走线连接，因为大电流会引起较大的压降，会导致压降比较大，对输出功率有较大影响，电源中如存在较大的阻抗甚至影响声音会出现卡顿情况。
- 输入电容 (Cin) 、输入电阻 (Rin) 尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- SL8313 的底部散热片是芯片唯一接地点，必须连接在 PCB 板上，设计 PCB 时，底部一定需要开窗，用与芯片和 PCB 的 GND 连接，同时对芯片散热有很大的帮助，PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，SL8313 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.5mm 以上。

■ DEMO板参考图



■ 芯片封装 ESOP-10



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.80	2.10	0.070	0.082
B	3.10	3.40	0.122	0.133
b	0.38	0.50	0.015	0.019
C	3.80	4.00	0.149	0.157
C1	6.00	6.20	0.236	0.244
C2	1.35	1.55	0.053	0.061
C3	0.1	0.25	0.004	0.010
D	4.8	5.0	0.189	0.197
D1	1.35	1.55	0.053	0.061
e	1.00 (BSC)		0.039 (BSC)	
L	0.520	0.720	0.02	0.028
θ	0°	8°		

声明 1：芯朗半导体（深圳）有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。

声明 2：芯朗半导体（深圳）有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。